

电参数

Vin=12V, Ta=25° C, 特殊条件除外。

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
Vfb	反馈电压	4.5<Vin<60V	0.792	0.812	0.832	V
Rsw	开关导通电阻	Vbst-Vsw=5V		1		Ω
Iswleak	开关漏电流	Ven=0V, Vsw=0V			1	uA
Ilim	极限电流			1.5		A
Fosc	震荡频率		380	480	580	KHZ
Fsw-f	折返频率	Vfb=0V		150		KHZ
Vuvlo-r	欠压开启电压		2.9	3.3	3.73	V
Vuvlo-f	欠压关断电压		2.65	3.05	3.45	V
Ton min	最小开关打开时间			100		ns
Venr	使能开启电压			1.35		V
Venf	使能关断电压			1.0		V
Ien	EN 输入电流	Ven=2V		3.1		uA
		Ven=0V		0.1		uA
Iq	静态电流	Ven=2V, Vfb=1V		0.73	0.86	mA
Is	关机电流	Ven=0V		0.1	1.0	uA
Tsd	热关机			165		° C

管脚功能

管脚号	名称	功能
1	BST	自举脚。内部提升高边MOSFET驱动管的正电源极。在该脚与SW之间连接一个升压电容。
2	GND	接地脚。它的连接尽可能接近输出电容，避开高电流开关路径。
3	FB	反馈。误差放大器的输入。设定输出电压。当负载短路时，FB电压低于250mV，折返电路将降低震荡频率以保证可靠的限流保护。
4	EN	使能输入。把该脚电压拉到低于指定的门限将关闭芯片。拉到高于指定的门限使芯片工作。接100K电阻到IN可自动开启。
5	IN	电源输入。所有内部控制电路供电。需要接一去耦电容到地以减少开关尖峰。
6	SW	开关输出脚。需要就近接一个低VF的肖特基二极管到地以减少开关尖峰。

工作原理及应用

HE2459是一款480KHz震荡频率、内部集成有高压功率MOSFET的电流模式降压型开关稳压电路，电路内部误差放大器的输出是比例于峰值电感电流，将反馈信号与内部0.812V基准电压比较，稳定输出的电压。它具有宽输入电压范围，精确的电流限制，非常低的静态工作电流适合使用电池供电的应用场合。

元器件选择

设定输出电压

输出电压由接到FB端的输出电压的分压器的电压设定，反馈的分压比依公式：

$$V_{FB} = V_{OUT} * R1 / (R1 + R2)$$

各输出电压的参考电阻

Vout (V)	R1(KΩ)	R2(KΩ)
1.8	80.6 (1%)	64.9 (1%)
2.5	49.9 (1%)	23.7 (1%)
3.3	49.9 (1%)	16.2 (1%)
5	49.9 (1%)	9.53 (1%)

电感

在输入开关电压时，电感用于为输出负载提供连续的电流，大的电感可得到较低的输出纹波。通常，电感的选择是电感额定电流要比最大负载电流大30%。同时使峰值电流小于最大开关电流，在最大电感峰值下不会饱和。

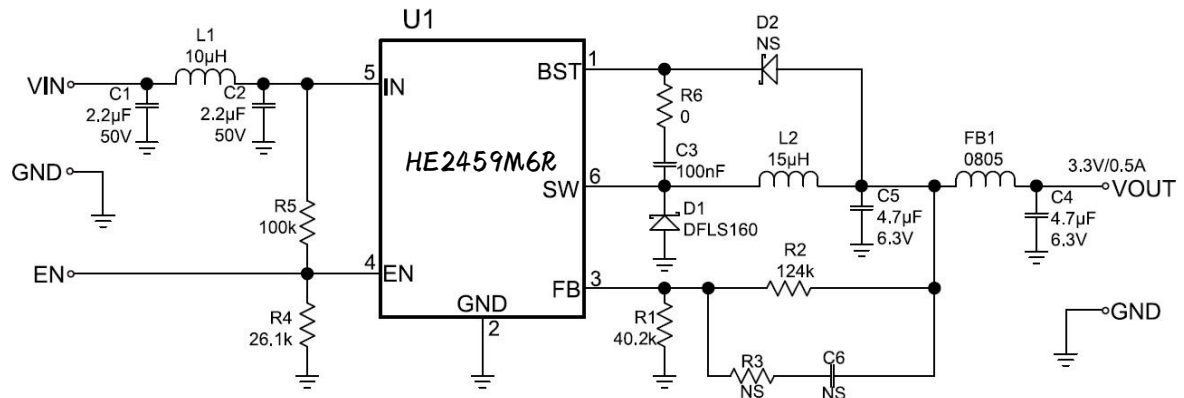
输入电容

输入电容器可以是电解、钽或陶瓷电容。当使用电解或钽电容时，需用一小的陶瓷电容器，例0.1uF就近放置在电路旁。当使用陶瓷电容,确保他们有足够的电容值防止输入过度的电压纹波。

输出电容

输出电容器用来保持输出直流电压。推荐采用低ESR的电解电容器以保持低的输出电压纹波。输出电容器的特性会影响稳压系统的稳定性。

典型应用线路



3.3V输出应用图

PCB布局

PCB布局对电路实现稳定工作非常重要，以下建议供参考：

- 1) 开关电流路径尽量短，输入电容、高边MOSFET和外部开关二极管形成的环路区域尽量小。
- 2) 旁路陶瓷电容靠IN端就近放置，SW输出相关走线尽量短而粗。
- 3) 所有反馈电路连接需短而直接，反馈电阻和补偿元件尽可能靠近芯片。
- 4) SW路线远离敏感的模拟区域，如FB。
- 5) SW、IN、特别是地要分别连到一个大面积覆铜区域，以冷却芯片、改进热性能和加强长期的可靠性。

